

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日時 平成20年11月7日（金）13:00～17:50

場所 首都大学東京南大沢キャンパス 91年館 多目的ホール（〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1，京王相模原線「南大沢」駅下車，改札口から徒歩5分
http://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide.html）

テーマ「ワイドギャップ半導体材料，デバイス一般」

- EFM-08-35 GaN 表面の電気化学酸化とデバイス表面制御への応用
塩崎奈々子，原田脩央，橋詰 保（北海道大学） …… 1
- EFM-08-36 高耐圧 GaN-HEMT におけるバッファ層構造と電気的特性の相関
齋藤 渉，野田隆夫，蔵口雅彦，高田賢治，津田邦男，齋藤泰伸，
大村一郎，山口正一（東芝） …… 5
- EFM-08-37 V_T - V_{SUB} 特性を用いた p-GaN 上の AlGaIn/GaN HFET バッファ層評価
胡 成余，中谷克俊，敖 金平，大野泰夫（徳島大学）
菊田大悟（豊田中央研究所）
杉本雅裕（トヨタ自動車） …… 11
- EFM-08-38 AlGaIn/GaN HFET のゲートエッジ負帯電による電流コラプスの2次元数値解析
井川裕介，湯浅頼英，胡 成余，敖 金平，大野泰夫（徳島大学） …… 17
- EFM-08-39 高耐圧 E-mode AlGaIn/GaN HEMT 実現のための新規リセス構造
多木俊裕，吉川俊英，金村雅仁，今西健治，原 直紀，常信和清（富士通） …… 23
- EFM-08-40 ノーマリオフ型 GaN 系 RESURF-MOSFET における 1500 V/2 A 動作
新山勇樹，神林 宏，大友晋哉，池田成明，
野村剛彦，加藤禎宏（古河電気工業） …… 29

協賛 電気学会次世代ハイパワー・高周波応用ワイドギャップ半導体材料技術調査専門委員会